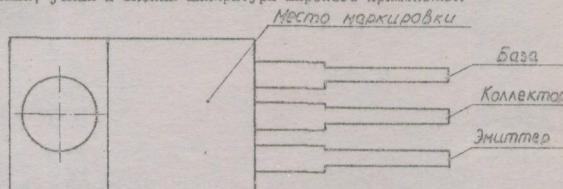




ТРАНЗИСТОРЫ КТ819А, КТ819Б, КТ819В, КТ819Г

ЭТИКЕТКА

Кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п транзисторы типов КТ819А, КТ819Б, КТ819В, КТ819Г в пластмассовом корпусе, предназначенные для применения в ключевых и линейных схемах, узлах и блоках аппаратуры широкого применения.



Масса не более 2,5 г

$$T_{\text{сп}} = (25 \pm 10)^\circ\text{C}$$

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения, тип транзистора	Буквенное обозначение	П р о м а не менее	П р о м а не более
Статический коэффициент передачи тока ($I_3 = 5 \text{ A}$, $U_{K5} = 5 \text{ В}$) КТ819А, КТ819В	h_{213}	15	275
КТ819Б		20	275
КТ819Г		12	275
Обратный ток коллектора, мА ($U_{KB} = 40 \text{ В}$)	I_{KB0}	—	I
Границчное напряжение, В ($I_3 = 0,3 \text{ A}$, $t_u = 270-330 \text{ мкс}$) КТ819А	$U_{K30 \text{ гр}}$	25	—
КТ819Б		40	—
КТ819В		60	—
КТ819Г		80	—
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В ($I_K = 5 \text{ A}$, $I_S = 0,5 \text{ A}$) КТ819АС	$U_{KЭнас}$	—	2

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ В 1000 шт. ТРАНЗИСТОРОВ:

серебро — г

Содержание цветных металлов в транзисторе: медь — г

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы КТ819А, КТ819Б, КТ819В, КТ819Г соответствуют техническим условиям в А.336.189 ТУ/02

Место для штампа ОТК

Место для штампа «Перепроверка произ. дена

Место для штампа ОТК